

Кукушкин Сергей Арсеньевич

доктор физико-математических наук, профессор
заведующий лабораторией структурных и фазовых превращений в
конденсированных средах Института проблем машиноведения РАН, г. Санкт-Петербург

ФГБУН ИПМаш РАН, Васильевский остров, Большой проспект, 61

Санкт Петербург, Россия, 199178

Тел. : +7-812-3214778, ksa@math.ipme.ru

Список основных публикаций в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1. N.A. Feoktistov, S.A. Grudinkin, V.G. Golubev, M.A. Baranov, K.V. Bogdanov, S.A. Kukushkin Evolution of the morphology of diamond particles and mechanism of their growth during the synthesis by chemical vapor deposition / Semiconductors, Physics of the Solid State, November 2015, Volume 57, Issue 11, pp 2184-2190
2. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, Фазовый переход первого рода через промежуточное состояние // ФТТ. Т. 56, (2014), вып. 4, с. 761-768.
3. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, А.В. Редьков, Критерий морфологической устойчивости сферического фронта кристаллизации в многокомпонентной системе с химическими реакциями. // ФТТ, т. 56, (2014), вып. 12. с. 2440-2445
4. А.С. Гращенко, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, Наноиндентирование и деформационные свойства наномасштабных пленок карбида кремния на кремнии. // Письма в ЖТФ, 2014, том 40, выпуск 24, с. 53-59.
5. В.Н. Бессолов, Е.В. Коненкова, С.А. Кукушкин, А.В. Мясоедов, А.В. Осипов, С.Н. Родин, М.П. Щеглов, Н.А. Феоктистов, Эпитаксия полуполярного GaN на подложке Si(001) с буферным слоем SiC // Письма в ЖТФ, 2014, том 40, выпуск 9, с. 48-54.
6. S.A. Kukushkin and A.V. Osipov. Topical Review. Theory and practice of SiC growth on Si and its applications to wide-gap semiconductor films. // J. of Phys. D: Appl. Phys., 2014, 47, p. 313001-313041
7. Kukushkin S. A., Osipov A. V. A new method for the synthesis of epitaxial layers of silicon carbide on silicon owing to formation of dilatation dipoles / JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2013, № 2, 113.
8. Kukushkin S. A., Osipov A. V., Kuz'michev S. V. Elastic interaction of point defects in crystals with cubic symmetry / Mechanics of Solids, 2013, № 4
10. Kukushkin S. A., Osipov A. V. Anisotropy of the Solid-State Epitaxy of Silicon Carbide in Silicon / SEMICONDUCTORS, 2013, № 12
12. Kukushkin S. A., Osipov A. V. Thin-film heteroepitaxy by the formation of the dilatation dipole ensemble / DOKLADY PHYSICS, 2012, № 5
14. Kukushkin S. A., Osipov A. V., Osipova E. V. The optical constants of zinc oxide epitaxial films grown on silicon with a buffer nanolayer of silicon carbide / JOURNAL OF OPTICAL TECHNOLOGY, 2011, № 7